連載 (解説)

# Common Data Processing System Version 10 の使用法 — (3) データ処理(その2) —

吉原 一紘<sup>\*</sup> オミクロンナノテクノロジージャパン(株) 〒144-0052 東京都大田区蒲田 5-30-15 <sup>\*</sup>k.yoshihara@omicron.jp

(2013年5月10日受理)

#### 5. 3 [analysis]

[analysis]には3種類のボタンが含まれる.

#### (1) ピークの同定





いるときには C-1s または O-1s ピークがスペクト ル上にあれば, [charge up compensation]グループボッ クスのボタンでいずれかのピークを選択すると縦線 が出現するので、その縦線の位置をピーク上の C-1s または O-1s ピークに合わせ、[shift]ボタンをクリッ クすると、チャージアップを補正して、ピーク同定 結果が表示される.

[save]ボタンをクリックすると同定結果がcsv形式 で保存される. ピーク位置を消去したり, ピーク名 称を変化したりした後に, [D]ボタンをクリックする と最初の同定結果の表示に戻る.

## (2) 定量

表示したスペクトルの定量分析を行う. ▲ をク リックして、マウスで定量したいピークを囲むと、 シャーリー法でバックグラウンドを差し引いた面積 が制御パネルに表示される.なお、微分系のスペク トルの場合はピーク高さが表示される.領域の大き さはマウスで領域の線上をドラッグすることで変更 できる.ピークの指定を取り消したいときには、マ ウスで囲んだ領域内で右クリックする.ピークが小 さく、マウスで囲むことが難しい場合には[Z]ボタン をクリックし、領域を指定して、再度[Z]ボタンをク リックすると指定領域が拡大される.その後、拡大 されたピークをマウスで囲む.ピーク指定後に青い



[X]ボタンをクリックすると元の画面に戻る.

[intensities],[concentrations],[sensitivity],[figure] の tab からなるテーブルが制御パネルに現れる. [intensities]のtabには、ピーク位置とピーク面積(微 分ピークの場合はピーク高さ)が示される. ピーク 位置のカラムのチェックボックスにチェックを入れ ると、ピーク分離画面が現れ、ピーク分離が出来る. 複数ブロックが同時表示されているときには、ブ ロック番号が表示される. [save]ボタンをクリックす ると、定量結果を csv 形式で保存することが出来る.

[concentrations]の tab をクリックすると,相対感度 を用いた定量値が表示される. [sensitivity]の tab を



# (3) 因子分析 (factor analysis)

スパッタリングや照射損傷のように時間経過と共 に変化するスペクトル群を解析する際に、スペクト ル群を構成する基本となる成分の数とその成分のス ペクトルを求め、それらが時間と共にどのように変 化するかを求める方法が因子分析である.因子分析 を適用するためには、一連のスペクトルが基本とな る成分のスペクトルの線形結合で表すことが出来る ことが前提である.



マウスで囲む.

制御パネルに固有値解析の結果が現れ,固有値が 一定以上(閾値のディフォールトの値は10<sup>-3</sup>である が,閾値を示すバーをマウスで移動させることによ り変更できる)の値を有する成分の数が表示される. 表示のスペクトル群の場合は「2」個である.



画面の下部のパネルに現れる[save]ボタンをク リックすると,解析結果が csv 形式で保存される. また,[copy fig.]ボタンをクリックすると画像が jpg 形式で保存される.

次に基本となる成分のスペクトルを求める. COMPROで採用している因子分析法は,実測された データ群の中から基本となるスペクトルに近似して いると思われるスペクトルをあらかじめ"target"と して選択し,それに最も近似するスペクトルを数学 的に合成して基本成分とするという方法である.表 示されている例では,成分数は「2」と決定してい るので,2本のスペクトルを測定したスペクトル群 の中から"target"として選択する.

[target]タブをクリックするとスペクトルのブロッ クを選択する画面が図の下部に表示される.ブロッ



ク番号を変えると、対応するブロックのスペクトル が表示されるので、スペクトル形状を観察しながら 指定された成分数の数だけスペクトルを選択する.

スペクトルを選択すると,選択したブロック番号 が記録される.

表示されている例では, target として測定開始時と 測定終了時に取得したスペクトルを選択した.指示 されている本数のスペクトルを選択後[display]ボタ ンをクリックすると選択したスペクトルが同時表示 される.



[set]ボタンをクリックすると、選択したスペクト ルに最も近似するスペクトルを数学的に合成して基 本成分を決定し、基本成分が時間とともにどのよう に変化するかを表示する.



[component]タブをクリックすると、合成された基本成分のスペクトルが表示される. "target"として選択したスペクトルに近似しているか否かを確認できる.

因子分析法はスペクトル群が基本成分の線形合成 で表せることが前提である.この前提に合わないと きには「表示されているスペクトル群は因子分析に は適さない」という警告文が現れる.

#### 5. 4 [thin film]

[thin film]には4種類のボタンが含まれる.

#### (1) MRI モデルによる depth profile 解析

MRI モデルは Hofmann により提案された, depth profile の界面の形状は mixing, roughness, information depth によって決定されるというモデルである. この モデルに基づき, 界面の形状をシミュレーションに より求めて, それを実測値と比較して, 真の界面構 造を推定する方法である.

▲ボタンをクリックして MRI 解析を行う領域を マウスで囲む.なお、表示されているスペクトルは depth profile である必要がある.depth profile 以外の スペクトルでは「MRI 解析は適用できない」という 警告文が現れる.



MRI解析を実施するためには基準となるピーク強度として,対象とする物質の濃度が100%の時の強度を求める必要がある.画面上で緑のバーを移動させてバーの高さを設定する.バーの高さ(最大値と最小値)は制御パネルに表示される.

depth profile は横軸が時間なので、それを距離に変換する必要がある.

スパッタリング速度 を入力して[set]ボタ ンをクリックすると, 横軸に変換され, スペクトルの表 示範囲はMRIで解析 する領域に拡大され る. さら示領域下部に 現れる層構造の入力 画面の背景色が薄緑



に変わり入力可能になる.



層構造の入力画面上をマウスでクリックすると, 層構造を示す濃い緑のボックスが現れ,それに対応 した depth profile が MRI モデルで計算されて,スペ クトルに濃緑の線で上書きされる.層構造を示す ボックスの位置,高さ,厚さはマウスで変更できる. また入力画面の下部にあるテキストボックスの値を 変更しても変えられる.濃緑のボックス以外の場所 をクリックすると新たにボックスを作ることができ るし,それを移動して既存の濃緑のボックスと合体 させることもできる.また,ボックスが不適当だと 思われる時には,マウスでそのボックスを右クリッ クすると消去できる.

制御パネルは、横軸が距離に変換されると自動的 に[MRI]タブに変わり、MRI モデルに必要なパラ

メーターの入力画 面となる.パラ メーターを変更し ながら,MRIモデ ルで計算された depth profileと実値 を求うかれた るる.最適 がどうかーの目視に な存する.な約 に MFP データは COMPRO のデー タベースを利用し て計算されている.



### (2) Thickogram による膜厚の決定

Thickogram は Cumpson によって提案された方法 で、単層の薄膜の膜厚を求める方法である.単層の 薄膜の厚さは、基板から放出される電子と、薄膜か ら放出される電子の運動エネルギーが大きく違わな ければ簡単に求められる.しかし、それらが、大き く違うときには解析が複雑となり、簡単に膜厚を求 めることはできない.Thickogram はその複雑な解析 を図面上で処理して、膜厚を求める方法である.

▲ ボタンをクリックして,基板と薄膜からの光 電子のピークをマウスで囲む.



制御パネルには指定されたピークの強度(面積) が示される.制御パネルの[deconv.]ボタンをクリッ クすると指定したピークのピーク分離が出来る.次 に基板に対応するピークを指定すると,Thickogram による解析が行われ,膜厚が与えられる.ただし, COMPRO では Cumpson が提案した式の解を図上で 求めることはせずに,繰り返し計算により求めてい る.

oubor.	energy	intensity	sensiti	vity	databas
$\odot$	103.79	5307	1.00	÷	
~ •	99.66	12705	1.00	1	
thickne	ss of over	ayer			
thickne t /(IMFP	ss of over * cos0)	0.35			

Thickogramでは基板と薄膜のピークの運動エネル ギーの比と強度(相対感度で補正)の比を基に, thickness/(IMFP×cos(emission\_angle))の値を 与える.IMFPデータは COMPRO のデータベースを 利用して計算されるので,その値を入れると薄膜の 厚さが求められる.[Thickogram]タブをクリックす ると, Cumpson が提唱した図面上での解析方法とそ の結果が表示される.

(3) Tougaard 法によるバックグラウンド解析 Tougaard は薄膜の構造とそのエネルギー損失関数 を仮定することによりバックグラウンドを算出し, それを実測データと比較して薄膜の構造を求める方 法を提案した. ★ボタンをクリックすると表示されたスペクト ルが透過関数補正されて表示される.ディフォール トの透過関数は E<sup>-0.7</sup> であるが、制御パネルの [transmission function]グループボックスで変更でき る.解析に使用するピークをマウスで囲み、[set range]ボタンをクリックする.



指定したピーク領域が拡大される. Tougaard 法で は,高運動エネルギー側のバックグラウンドを直線 で近似して差し引く必要があるので,この画面で直 線バックグラウンドを指定する.



解析する範囲は赤い縦線をマウスでドラッグする ことにより変更できる.高運動エネルギー側のバッ クグラウンドを示す直線は,直線上のハンドルをマ ウスでクリックしてドラッグして移動させ,最適の 位置に移動させる.最適かどうかの判断はユーザー の目視に依存する.

解析する範囲,および直線バックグラウンドの位置を確定した後,制御パネル上の[analysis]ボタンを クリックすると[analysis]タブが現れるので,エネル ギー損失関数,薄膜の形状,IMFPを指定する.な お,表示されているスペクトルは直線バックグラウ ンドが差し引かれた形状である.

エネルギー損失関数は、コンボボックスをクリッ クして metals/oxides, polymers, silicon oxide, silicon, germanium, aluminum の中から選択する. 薄膜の形状 は, buried layer, exponential profile, homogeneous の中



から選択する. 薄膜の形状を選択すると, 薄膜の形 状を表す赤いボックスが現れる. 赤いボックスをマ ウスでドラッグすると薄膜の形状や位置を変えるこ とができる. IMFP データは COMPRO のデータベー スを利用して計算される値が用いられる. 入力した データに対応してバックグラウンドが計算されスペ クトルに上書きされる.

グラフ上には、①高運動エネルギー側の直線バッ クグラウンドが差し引かれたスペクトル、② Tougaard 法で得られたバックグラウンドが差し引か れたスペクトル、③Tougaard 法で得られたバックグ ラウンド、が描かれるので、薄膜の位置・形状をマ ウスで変化させながら、最も良くバックグラウンド を差し引くことが出来る薄膜構造を決定する.最適 かどうかの判断はユーザーの目視に依存する.



# (4) 二角法による多層膜の構造の推定

二角法とは基板の上に複数個の層が形成されてい るときに、低放出角度と高放出角度で測定したスペ クトル強度の比から多層膜の層順を推定する方法で ある.



二つのスペクトル上で、マウスで強度を比較した いピークを同時に囲むと、シャーリー法でバックグ ラウンドを差し引いた面積が制御パネルに表示され る.領域の大きさはマウスで領域の線上をドラッグ することで変更できる.ピークの指定を取り消した いときには、マウスで囲んだ領域内で右クリックす る.ピークが小さく、マウスで囲むことが難しい場 合には[Z]ボタンをクリックし、二つのスペクトルを 含むように領域を指定して、再度[Z]ボタンをクリッ クすると指定領域が拡大される.その後、拡大され たピークをマウスで囲む.このときも二つのスペク トルを含むようにピークの領域を指定する.ピーク 領域指定後に青い[X]ボタンをクリックすると元の 画面に戻る.



制御パネルに、二つのスペクトルのそれぞれについてピーク位置、ピーク強度が表示される. [layer order]タブをクリックすると、測定したピークについて層順が表示される.

ensity lay	ver order tra	nsition			
save	■	角度で測 ク番号を	定した  指定		
<ul> <li>block</li> </ul>	= 1 ( block	c = 2	層順 ↓		
peak	transition	ratio	order	-	
536.23		0.120	2		
290.60		0.418	1		
403.28		0.083	3	=	
		t			
	低放出角度と高放出				
	角度(	<b>Dピーク</b>	強度比	μ	
				-	

表示されている二つのピークのうちで、低放出角 度で取得したスペクトルのブロック番号を指定する. COMPRO はピーク強度が大きい方のスペクトルを 低放出角度で取得したスペクトルであるとしている が、そうで無い場合にはここで変更する.この場合 には、第1層は290.60eV のピークに対応する元素、 第2層は539.23eV のピークに対応する元素、第3層 は403.28eV のピークに対応する元素であると推定 される.

[transition]タブをクリックすると transition 名の データベースが現れるので, transition 名を選択する と[layer order]の表に記入される.

## 5. 5 [tool]

[tool]には2種類のボタンが含まれる.

(1) 文字の記入

スペクトルの表示画面に文字を記入することが出 来る. 20をクリックすると図のフレームの左上部に テキストボックスが現れるので,文字を記入してエ ンターキーを押す.取り消しする場合には,テキス トボックスの横の青い[X]ボタンをクリックする.



テキストボックスに記入された文字はスペクトル 表示画面の左隅にコピーされる.スペクトル表示画 面にコピーされた文字はマウスでドラッグして,希 望の場所に移動させることができる.文字の大きさ などの変更は文字上でマウスを右クリックするとコ ンボボックスが現れるので,メニューを指定して実 行する.

# (2) スペクトル表示画面のコピー

をクリックすると,現在のスペクトル表示画面を jpg 形式で保存できる.